بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی FAMAPb(IBr)₃

محمدجعفر نامور¹، محمدحسین عباسپورفرد^{1،*}، محمود رضائی رکن آبادی²، عباس بهجت³، مسعود میرزائی⁴ ¹گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ²گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ⁴گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران دریافت: 1396/10/09 ویرایش نهائی: 1397/06/17 پذیرش: 1397/07/09

چکیدہ

استفاده از کاتیونهای ترکیبی در سلولهای خورشیدی پروسکایتی ترکیبی بهدلیل افزایش ناحیهٔ طول موج جذبی و بهطیع آن بهبود کارایی بسیار امیدوار کننده است. در این تحقیق، کاتیون ترکیبی روبیدیم -سزیم (RbCsI2) بهمحلول اصلی پروسکایت با ساختار (Br) عمر اندوار کننده است. در این تحقیق، کاتیون ترکیبی روبیدیم -سزیم (RbCsI2) بهمحلول اصلی پروسکایت با ساختار و ید (I) می باشد. نسبت های روبیدیم و سزیم برابر هم انتخاب شد و نسبت محلول یدید روبیدیم -سزیم برابر %5 کل محلول اصلی پروسکایت در نظر گرفته شد. برای مقایسه سلولی دیگر بهعنوان سلول شاهد ساخته شد که در آن فقط کاتیون سزیم (CsI) بهمحلول اصلی پروسکایت در نظر گرفته شد. برای مقایسه سلولی دیگر بهعنوان سلول شاهد ساخته شد که در آن فقط کاتیون سزیم (SI) بهمحلول اصلی پروسکایت با ساختار فوقالذکر تزریق شد. در ادامه سلول ساخته شده حاوی کاتیون روبیدیم -سزیم با سلول شاهد بر اساس مشخصهیاییهای V-V معلی و معزیم میاشد. همچنین تصاویر MES نشان دادند که بازدهٔ سلول حاوی کاتیون روبیدیم -سزیم بر اساس مشخصهیاییهای V-V معلی و معزیم میاشد. همچنین تصاویر MES نشان دادند که حفرهها در پروسکایت حاوی کاتیون روبیدیم -سزیم کمتر از سلول شاهد حاوی سزیم میاشد. همچنین تصاویر معلی نشان دادند که مغره ها در پروسکایت حاوی بر این پیکهای موجود در الگوی پراش برای سلول حاوی کاتیون روبیدیم -سزیم شدان دادند که مغرها در پروسکایت حاوی نشاندهندهٔ بلورینگی و خلوص بیشتر پروسکایت حاوی کاتیون روبیدیم -سزیم شدت بیشتری نسبت بهسلول شاهد داشتند که نشاندهندهٔ بلورینگی و خلوص بیشتر پروسکایت حاوی کاتیون روبیدیم -سزیم بود که منجر بهانتقال بهتر حاملهای بار و بازده بیشتر سلول گردید. این مشخصهیاییها نشان داد که عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی حاوی کاتیون روبیدیم -سزیم نسبت بهسلول شاهد بهبود یافته است.

کلیدواژگان: سلول خورشیدی پروسکایتی، کاتیونهای ترکیبی، بلورینگی، بازده.

مقدمه با توجه به آلایندگی، هزینهٔ زیاد و رو به اتمام بودن ^{نو} منابع انرژیهای فسیلی و همچنین محدودیتهای ^{بر}

انرژی هستهای، اهمیت و ضرورت استفاده از انرژی نور نور خورشید را که منبعی پاک، نامحدود و رایگان است برای بشر آشکار میکند. سلولهای خورشیدی

^{* *}نویسنده مسول: abaspour@um.ac.ir

تجهيزاتي هستند كه رسيدن بهاين هدف مهم يعنى تبدیل انرژی تابشی خورشید را بهانرژی قابل استفاده محقق می سازند. سلول های فوتوولتائیک ، نور خورشید را مستقيماً بەانرژى الكتريكى تبديل مىكنند. سلول ھاي خورشيدي اولين بار در سال 1954 از مادهٔ سيليكون كه مادهای سمی و ساخت آن پر هزینه است، ساخته شدند. بعدها با تحقیقات بیشتر عملکرد سلول های خورشیدی بهبود و توسعه یافتند. برای مثال در یک کار شبیهسازی شده با استفاده از مادهٔ گالیم فسفات(GaP) به عنوان لایهٔ ذاتي بهجاي لاية سيليكون أمورف ذاتي بازدة سلول خورشیدی سیلیکونی را افزایش دادهاند [1]. همواره تحقيقات در زمينهٔ بهبود و توسعهٔ سلول های خورشيدی بهمنظور افزايش بازده، پايداري بيشتر، هزينهٔ ساخت کمتر و مواد کم ضررتر بوده است. یکی از یارامترهای مهم برای بهبود کارائی سلولهای خورشیدی، میزان جذب فوتون توسط سطح مؤثر سلول مىباشد. در اين ارتباط، در یک کار انجام شده با استفاده از برانگیختگی مدهای اپتیکی درون سلول، احتمال جذب فوتون توسط سلول را افزایش دادهاند که این امر موجب افزایش بازده سلول شده است [2]. سلولهای خورشیدی پروسکایتی، نسل سوم از سلولهای خورشيدي فوتوولتائيک ميباشند. اين نوع سلولهاي خورشیدی که اخیراً توجه بسیاری از پژوهشگران را بهخود جلب كرده است، نانوساختاري مي باشند (شكل 1).



شکل1. طرح شماتیک سلول خورشیدی پروسکایتی ترکیبی شامل لایههای رسانای شفاف(FTO، یلاک با ضخامت تقریبی30 نانومتر، مزوپروس با ضخامت تقریبی 100 نانومتر، پروسکایت (400 نانومتر)، انتقالدهندهٔ حفره (50 نانومتر)، لایهٔ طلا (60 نامومتر).

این توجه بهخاطر ویژگیهای فوقالعادهٔ مادهٔ پروسکایت از قبیل افزایش جذب نور، طول پخش زیاد حاملهای بار، اندازهٔ گاف (band-gap) کم و قابل تنظیم، و بازترکیب پایین حاملهای بار می باشد [5-3]. مادهٔ پروسکایت اولین بار در سال 2009 برای بهبود مادهٔ پروسکایت اولین بار در سال 2009 برای بهبود جاذب نور جامد استفاده شد. برای این منظور ماده پروسکایت جایگزین رنگدانه در سلول خورشیدی رنگدانهای شد و بازده قابل توجه %8/8 برای سلولهای

خورشیدی حساس شده گزارش گردید [6]. بعدها با بهینه سازی الکترولیت مایع بازده این نوع از سلول ها به %5/6 رسید [7]. عیب مهم سلول های حساس شده، پایداری کم سلول میباشد. در ادامه پژوهش های سلول های حساس شده، پژوه شگران الکترولیت جامد را جایگزین الکترولیت مایع کردند و این نوع از سلول ها را بهبود دادند که بهبود این نوع از

¹ Photovoltaic

سلولهای خورشیدی توسط پژوهشگران ادامه دارد [8.۹]. همان طور که اشاره شد سلولهای خورشیدی پروسکایتی به خاطر هزینه پایین ساخت، روش ساخت آسان و استفاده از مواد کم ضرر و بازدهٔ قابل مقایسه با سلولهای نسل اول، قابل رقابت با سلولهای سیلیکونی می باشند. بنابراین در صورت بهبود راندمان و پایداری می توانند جایگزینی مناسب برای سلولهای خورشیدی سیلیکونی باشند. یکی از لایه های مهم در این سلولهای خورشیدی نانوساختاری لایه جاذب نور پروسکایت می باشد. جذب نور بیشتر توسط لایه جاذب یکی از پارامترهای مهم در عملکرد بهتر سلول خورشیدی می باشد.

فرمول کلی این لایه بهصورت ABX3 میباشد. بهطوری که A یک کاتیون یک ظرفیتی مثل متیل آمونیم (CH₃(NH₂)₂).FA یک کاتیون یک ظرفیتی MA سزیم(CS)، سدیم(Na) و روبیدیم (Rb) میباشد. یک فلز دو ظرفیتی است که میتواند ژرمانیم (^{+C}Ge) یک فلز دو ظرفیتی است که میتواند ژرمانیم (^{+C}Ge) تلع (^{+C}R) و یا سرب (^{+C}pb) باشد. X یک هالوژن است که آنیون لایهٔ جاذب میباشد و میتواند کلر (^{-C}I)

تا کنون برای بهبود سلولهای خورشیدی پروسکایتی برروی قسمتهای مختلف آن کار شده است. تحقیقاتی که بر روی کاتیونها و مخصوصاً ترکیب کاتیونها و ترکیبکردن آنیونها انجام شده باعث بهبودی بیشتر سلول شده است [12-10]. از این رو در حال حاضر بهترین سلولهای خورشیدی پروسکایتی سلولهایی هستند که کاتیون آنها ترکیبی از AA, MA و یک کاتیون دیگر مثل سزیم CS یا کاتیون دیگر میباشد و آنیون سلول هم ترکیب برم(Br) و ید(I) میباشد که این

ساختار را اصطلاحاً FMC گویند [71-13]. پروسکایت حاوی کاتیونهای FMC نسبت به پروسکایت حاوی کاتیونهای FM/MA پایداری بیشتری دارند. زیرا بهطور کلی تزریق عناصر غیر آلی و مواد گوناگون دیگر بهمحلول پروسکایت باعث افزایش آنتروپی و پایداری سلول، تغییر نرخ هستهزایی و اندازهٔ هسته، مورفولوژی و افزایش بلورینگی پروسکایت میشود. این مجموعه پارامترها باعث بهبود پایداری و بازدهٔ سلول میشوند. اثرات دیگر تبادل هالیدها با کاتیونها و مواد دیگر عبارتند از افزایش جذب نور مرئی [18]، کاهش انرژی تحریکی، رسیدن طول پخش الکترون حفره به میکرومتر، کاهش اندازه گاف و گاف انرژی قابل تنظیم از 1/1 تا 2/3 الکترون ولت. [19،20].

ترکیبکردن پروسکایتهای خالصی مانند MAPbI₃ و FAPbI₃ و CsPbI₃ که نتیجهٔ آن کاتیونهای ترکیبی است باعث بهبود پایداری و بازدهٔ سلول می شود. پروسکایت FAPbI₃ نسبت بهپروسکایت FAPbI₃ دارای باند گپ کوچکتر است اما FAPbI₃ بهتنهایی در دمای اتاق کریستالی میشود پایداری ساختاریش را نیز از دست میدهد. در یک پژوهش انجامشده، با اضافه کردن پروسکایت MAPbBr₃ به پروسکایت FAPbI₃، پروسکایت FAPbI₃ را پایدارتر و بازده سلول را نیز افزایش دادهاند [21]. در تحقیقی دیگر که از کاتیون ترکیبی FA با Cs بهصورت FA_{0.3}Cs_{0.1} استفاده شد، جذب نوری و بازدهٔ بیشتر بهدست آمد [22]. بیشترین اثر سزیم در پروسکایتهای سه کاتیونه، افزایش پایداری سلول میباشد [23]. در خصوص آنیونها نیز هالیدI از هالیدBr اثر بهتری دارد چون پروسکایت CsPbBr₃ از پروسکایت CsPbBr₃ باند

محمدجعفر	كاتيون تركيبي	اضافهكردن	بررسي اثر
-	·	-	

محمدجعفر نامور و همکاران

گپ مناسب تری دارد [24]. علاوه بر باند گپ، ید نسبت به برم جذب نوری بیشتری نیز دارد [25]. اضافه کردن مقدار کمی از کاتیون های کوچکتر مثل MA به کاتیون های بزرگتر مثل FA باعث بلورینگی شدن و پایدارشدن بیشتر فاز پروسکایت می شود. کاتیون سزیم غیرآلی که اخیراً توجه پژوهشگران زیادی را بهخود جلب کرده است دارای شعاع یونی1/81 آنگسترم است که نسبت به شعاع یونی MA آنگسترم است آنگسترم) و FA (2/79 آنگسترم) کوچکتر می باشد [26]. محققين اين اثر را بهوسيلة تركيب Cs/MA بررسی کردهاند [27]. محققین دیگر با اضافهکردن مقدار کمی کاتیون سزیم Cs بهکاتیون FA بهنتیجه مشابه رسیدند [28]. پژوهشگران تأیید کردند که دلیل بهبودی سلول با اضافه کردن کاتیون های کوچکتر به کاتیون های بزرگتر (مانند کاتیون ترکیبی Cs/MAیاCs/FA و یاMA/FA)، تنظیمشدن شعاع یونی مؤثر ترکیب و در جهت افزايش فاكتور تلرانس گلدشميت ميباشد [29،30]. در كاتيون هاى تركيبي سه گانهٔ FA/MA/Cs هر کاتیون بهطور جداگانه و منحصر بهفردی فاز فتواكتيو(سياه) پروسكايت را نشان مي دهد [31،۳2]. تنظيم كردن فاكتور تلرانس گلدشميت يكي از پارامترهایی است که می تواند نشانهٔ بهبودی سلول باشد. این فاکتور از رابطهٔ زیر بهدست می آید :

 $t = r_A + r_I \left(2^{1/2} (r_{pb} + r_I) \right)^{1/2}$

که در آنr شعاع یونی و t بین8/0 تا 1 میباشد [33] و تقریباً شامل همهٔ کاتیونهای کوچک میباشد. مواد قلیایی که میتوانند شامل کاتیون یا کاتیونهای ترکیبی لایهٔ جاذب سلول پروسکایتی باشند عبارتند از :

لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سزیم، MA و FA این مواد از مواد بی ضرر هستند و نسبت به ترکیبات dP و Sn مستعد اکسیداسیون هستند که در صورت استفاده در لایهٔ جاذب بهعنوان کاتیون باعث افزایش فاکتور تلرانس گلدشمیت و افزایش پایداری و بازدهٔ سلول میشود [34]. با توجه به محاسبات فاکتور تلرانس، مشود [34]. با توجه به محاسبات فاکتور تلرانس، دو SPbI3 و SPbI4 و FAPbI4 فاز فتواکتیو پروسکایت را بهبود می بخشد و در یک تحقیق که فیلمهای پروسکایت BPbI3 و SPbI53 در درجه فیلمهای پروسکایت فتواکتیو و فاز زرد پروسکایت که فاز سیاه پروسکایت فتواکتیو و فاز زرد پروسکایت غیر فتواکتیو از هم تفکیک شدند [35].

در گروه مواد قلیایی ذکر شده، با آنکه لیتیم، سدیم و پتاسیم خارج از دامنه هستند ولی RbPbI3 با یک اختلاف کوچکی کمتر بهبود مییابد که این اختلاف کم یک مزیت است. این اختلاف کم بهخاطر اختلاف کوچک در شعاع یونی روبیدیم (152 پیکومتر) و سزیم (167 پیکومتر) میباشد. اما ممکن است ترکیب دو کاتیون روبیدیم و سزیم سبب بهبودی بیشتر نسبت به کاتیون سزیم بهتنهایی باشد.

در این مقاله به منظور بررسی تأثیر کاتیون های ترکیبی بر عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی، کاتیون های روبیدیم و سزیم به نسبت مساوی با هم ترکیب شدند. این کاتیون ترکیبی به محلول پروسکایت حاوی کاتیون و آنیون ترکیبی ₃(IBr)FAMAPb اضافه گردید، در حالی که به نمونهٔ شاهد فقط کاتیون سزیم به محلول پروسکایت ذکر شده اضافه شد. مقایسهٔ رفتار و عملکرد سلول های مورد مطالعه با توجه به

مشخصەيابىھاى نمودارجريان-ولتاژ وبازدە ، XRD و SEM مورد بررسى قرار گرفت.

کارهای آزمایشگاهی

مواد و روشها

الف- ساخت نمونهها

در این تحقیق پنج نمونه سلول حاوی کاتیون ترکیبی روبيديم-سزيم و پنج نمونه سلول كه فقط حاوى کاتیون سزیم بود، ساخته شد. در ابتدا شیشههای پوشش داده شده با اکسید رسانای شفاف FTO در ابعاد 1/4×1/4 سانتیمتر برش زده شدند. سیس شیشهها از سمت FTO و از طرف يک لبه بهاندازهٔ 2 تا 3 ميليمتر با استفاده از پودر روی و اسید کلریک نارسانا شدند، که اصطلاحاً آنرا "سونش¹" کردن گویند. پس از مرحلهٔ سونش، شیشهها (زیرلایهها) با آب و مایع ظرفشویی شسته شدند. بهمنظور حذف هر گونه مواد ناخالصی زیرلایهها در سه مرحله و هر بار بهترتیب با آب دوبار یونیزه، استون و اتانول شسته شدند و بعد از هر مرحله بهمدت 10دقیقه در دستگاه آلتراسونیک قرار داده شدند. پس از آن زیرلایهها بهمدت 20دقیقه در حرارت 120درجهٔ سانتیگراد در دستگاه Oven قرار داده شدند. بعد از حرارت دهی، محلولهای ساخته شده در دمای اتاق و تحت رطوبت 13% بهترتیب زیر بر روی FTO لايەنشانى شدند. ھمچنين سطح ناحيە فعال ھر سلول با استفاده از ماسک 0/09 سانتیمترمربع انتخاب شد.

لایهٔ بلاک دیاکسیدتیتانیوم:مادهٔ اصلی این لایه تیتانیوم ایزوپروپکساید TTIP است. برای محلول سازی ماده

این لایه ابتدا 70میکرولیتر اسیدکلریک دو مولار به 5میلیلیتر اتانول خالص اضافه شد. همچنین 700میکرولیتر TTIP به 5میلیلیتر اتانول خالص اضافه گردید. در حالیکه محلول دومی در حال چرخش و ترکیبشدن بود محلول اولی به صورت قطرهقطره به محلول دومی اضافه شد. سپس محلول نهایی به منظور نداشتن ناخالصی تصفیه گردید.

پس از آماده شدن محلول لایه نشانی، لایهٔ بلاک به روش لایه نشانی چرخشی (Spin Coating) بر روی FTO انجام شد. برای این کار 200 میکرولیتر از محلول TTIP ضمن چرخش با سرعت 2000 دور بر دقیقه به مدت 30 ثانیه روی FTO ریخته شد. سپس نمونه ها به مدت یک ساعت در دمای 500 درجه سانتیگراد در کورهٔ افقی حرارت داده شدند.

لایهٔ مزوپروس دیاکسید تیتانیم: برای محلولسازی این لایه یک گرم خمیر دیاکسید تیتانیوم TiO2 در 5سی سی اتانول حل شد. سپس جهت حل شدن کامل، محلول به مدت 12ساعت توسط همزن مغناطیسی و در دمای ثابت به هم زده شد. لایهٔ مزوپروس باید بلافاصله بعد از پخت لایهٔ بلاک، بر روی آن لایه نشانی شود. برای این کار 50میکرولیتر از محلول TiO2 را روی نمونه ریخته و لایه نشانی با روش چرخشی با 4000 دور بر دقیقه و مدت زمان 30 ثانیه انجام شد. در نهایت نمونه ها مجدداً نیم ساعت در دمای 500 درجه سانتیگراد پخت داده شدند.

لایهٔ جاذب پروسکایت: محلول اصلی لایهٔ جاذب، محلول پروسکایت با ساختار

¹ Etching

3/5 بود. برای تهیهٔ 5/5 FA0.87MA013Pb(I0.87Br0.13) میلی لیتر محلول پروسکایت مراحل زیر انجام شد. 3میلی لیتر محلول 5/1مولار PbI2 با غلظت 2916 با mg/3ml با 1میلی لیتر محلول 5/1مولار PbBr2 با غلظت 550mg/1ml ترکیب شد.

حلال محلولهای PbI₂ و PbBr ترکیب دوحلال DMF و DMSO با نسبت حجمی بهترتیب 4 به 1 و چگالی DMF برابر 940 و چگالی DMSO برابر 1100 میلی گرم بر لیتر بود.

محلولهای PbI₂ و PbBr بهمدت 10 دقیقه تحت دمای 180 درجهٔ سانتی گراد ضمن تکان دادن حرارت داده شدند تا کاملاً حل شوند. وقتی کاملاً حل شدند محلول شفافی بهدست می آید. محلول پروسکایت با فرمول زیر ساخته شد:

A: $0.2^{\text{gr}}\text{FAI} + 950^{\mu\text{L}}(\text{PbI}_2) ---->\text{FAPbI}_3$ B: $0.25^{\text{gr}}\text{MABr} + 183^{\mu\text{l}}(\text{PbBr}_2) ---$

 $C = A + B = 830^{\mu L} (FAPbI_3) + 170^{\mu L}$ (MAPbBr₃)

>MAPbBr₃

محلول بهدست آمدهٔ C، همان محلول پروسکایت است که شامل کاتیونهای ترکیبی FA و MA و آنیونهای ترکیبی Br و I می باشد. برای اضافه کردن کاتیون ترکیبی جدید، بهازای هر 950 میکرولیتر محلول پروسکایت، 50 میکرولیتر (معادل %5 محلول پروسکایت) کاتیون ترکیبی RbCSI2 اضافه شد تا محلول نهایی پروسکایت ترکیبی بهدست آید. برای سلول شاهد هم بهازای هر 950میکرولیتر محلول پروسکایت 50میکرولیتر(5%) محلول ICS اضافه شد. محلولهای

FAPbI3 و FAPbBr و همچنین محلول نهایی پروسکایت که شامل کاتیونهای ترکیبی جدید میباشد برای محلولسازی نیاز به حرارت دهی ندارند و در دمای اتاق با تکان دادن حل می شوند. محلول کاتیون CsI با جرم مولی 389/715g/litr و محلول کاتیون RbI با جرم مولی 18/5 g/litr با استفاده از حلال DMSO ساخته شدند و سپس این دو محلول به نسبت مساوی ترکیب شد تا کاتیون ترکیبی جدید RbCsI2 به دست آید.

مرحله بهصورت زیر انجام شد. برای لایهنشانی پروسکایت، 40میکرولیتر از محلول پروسکایت آماده شده بر روی هر نمونه ریخته شد و مراحل زیر انجام گردید:

Step1: 1000 rpm/min, 15s

Step2: 4000 rpm/min, 30s

در 15 ثانیه آخر لایهنشانی در مرحلهٔ دوم، مقدار 200 میکرولیتر کلروبنزن به صورت ملایم ودر حدود 8/0 ثانیه روی نمونه ریخته شد. برای پخت لایهٔ پروسکایت بعد از اتمام لایهنشانی، نمونه ها یک ساعت در دمای 100 درجهٔ سانتی گراد صرفاً روی صفحهٔ داغ حرارت داده شدند. لایهنشانی پروسکایت در دمای محیط 30 درجهٔ سانتی گراد و رطوبت هوای 13% انجام پذیرفت.

لایهٔ انتقال دهندهٔ حفره Spiro-OMeTAD: برای تهیهٔ 1میلی لیتر از این محلول انتقال دهندهٔ حفره به صورت زیر عمل شد:

1 - (72.3 mg) Spiro in 1ml (Cholorobenzen)
2 - (520 mg) LiTFSI in 1 ml (Acetonitrite)

مقدار 28/8 میکرولیتر (معادل 26/6 میلی گرم) تری بوتیل پیریدین TBP بهمحلول اولی اضافه شد و سپس 17/5 میکرولیتر از محلول دوم بهمحلول اولی اضافه شد. در نهایت محلول حاصل که همان محلول اسپایرو می باشد بهمدت 30دقیقه در دمای 60درجهٔ سانتی گراد حرارت داده شد.

لایهٔ انتقال دهندهٔ حفره، بلافاصله بعد از حرارت دهی لایهٔ پروسکایت و رسیدن دمای سلول به دمای اتاق، به روش لایه نشانی چرخشی پوشش داده شد. برای لایه نشانی این لایه، مقدار 30میکرولیتر محلول اسپایرو روی هر نمونه ریخته شد و با سرعت 4000 دور بر دقیقه به مدت 30 ثانیه لایه نشانی شد. بعد از لایه نشانی اسپایرو نمونه ها ثانیه لایه نشانی شد. بعد از لایه نشانی اسپایرو نمونه ها داخل دسی کاتور قرار داده شد و با پوشش، نمونه ها از نور هم محافظت شدند.

لایهٔ کاند طلا: لایهنشانی کاند بهروش تبخیری در خلأ انجام شد. از مادهٔ طلا برای رسانش بهتر استفاده گردید. مقدار طلای مورد استفاده برای این منظور 75میلی گرم بود که با آهنگ 4آنگسترم بر ثانیه بر روی لایهٔ انتقالدهندهٔ حفره لایهنشانی شد. ضخامت تقریبی لایهٔ طلا با توجه بهکالیبره بودن سیستم لایهنشانی حدود 60نانومتر در نظر گرفته شد.

ب: مواد و تجهيزات:

مواد مورد اسفاده در این تحقیق ساخت شرکتهای ذیل بودند:

حلالهای شیمیایی از شرکت مرک آلمان؛ FA,MA از شرکت دایسول؛ انتقال دهندهٔ حفره -Spiro TBP از شرکت برون، ترت بوتیل پیریدین

از شرکت الدریج. بقیهٔ مواد از شرکت شریف سولار خریداری گردید. دستگاه شبیه ساز نور خور شید ساخت شرکت شریف سولار بود. شدت نور دستگاه برای اندازه گیری ها، با استفاده از سلول سیلیکونی استاندارد کالیبره شد و برای مشخصات نوری MA 5/1 و 100 mW/cm² و گسترهٔ طیفی 380 تا 9000 نانو متر تنظیم گردید. مقادیر جریان و ولتاژ با استفاده از دستگاه کیتلی (Keithley) مدل 2400 ساخت امریکا متصل به دستگاه شبیه ساز خور شیدی و رایانهٔ مجهز به نرم افزار لب ویو (Lab view) اندازه گیری شد.

نتايج و بحث:

همانطور که قبلاً بیان شد در این تحقیق دو نوع سلول ساخته شد. در سلول نوع اول به سلول خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی ،FA0.83MA0.17Pb(I0.83Br0.17)3 كاتيون تركيبي جدید بهنام یدید روبیدیم سزیم RbCsI2 اضافه گردید، بهطوریکه نسبت سزیم به روبیدیم مساوی و مقدار آن برابر با 5% کل محلول اصلی پروسکایت بود. در تر کیب حاصل، كاتيون ها عبارت بودند از FA, MA, Cs, Rb و آنيون اين تركيب، تركيب برم-يد Br/I. چون مقدار زياد برم باعث افزايش باند گپ پروسکايت می شود مقدار برم كم انتخاب شد. همچنين سلول نوع دوم كه قبلاً گزارشی از آن توسط محققین منتشر شده است [17] به عنوان سلول شاهد در نظر گرفته شد، به سلول خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی CsI فقط كاتيون FA0.83MA0.17Pb(I0.83Br0.17)3 اضافه گردید. برای مشخصه یابی نمونه های ساخته شده، بهترين نمونه سلول ساخته شده از هر نوع انتخاب شد

و همچنین متوسط بازده سلولها و خطای آنها محاسبه شدند. سپس دو نوع سلول ساخته شده با توجه بهنتایج بازده I-V تصاویر SEM و نمودار XRD مقایسه و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

نمودارهای جریان-ولتاژ مربوط به سلول های ساخته شده در شکل2 رسم شده است. همچنین سایر مشخصه های مربوط به دو سلول ازقبیل بازده ماکزیمم و بازده متوسط به همراه خطای آنها در جدول1 آورده شده است. نتایج نشان می دهد بازدهٔ سلول حاوی کاتیون RbCs بیشتر از بازدهٔ سلول حاوی فقط کاتیون Cs است.



شکل2. نمودار جریان ولتاژ سلولهای خورشیدی ساخته شده حاوی کاتیونهای روبیدیم-سزیم(منحنی آبی) و سزیم (منحنی قرمز).

ی CsI2 ساخته شده در این تحقیق.	ِن RbCsI₂ و كاتيون حاوى	ی پروسکایتی حاوی کاتیو	مشخصات سلولهاي	عدول1 . بازده و دیگر
--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------	-----------------------------

كاتيون	J _{CS} (mA/cm ²)	V _{oc} (V)	FF (%)	(Ave ± Stdv) Eff (%)	Eff (Max) (%)
RbCsI ₂	15 _/ 19	0,86	64/37	8/17±0/16	8,41
CsI	14 _/ 45	0,85	64,31	7/40±0/37	7,90

با توجه بهنمودارهای XRD، شدت پیک پروسکایت حاوی کاتیون روبیدیم-سزیم (شکل 3) بیشتر از شدت پیک پروسکایت حاوی کاتیون سزیم (شکل 4) می باشد. این امر نشاندهندهٔ بلورینگی بهتر و خلوص بیشتر پروسکایت حاوی کاتیون روبیدیم-سزیم نسبت به پروسکایت حاوی کاتیون سزیم می باشد. بلورینگی و خلوص بهتر پروسکایت باعث سهولت در انتقال بار در سلول و در نتیجه افزایش بازدهی سلول خورشیدی میشود. همچنین با توجه با نمودارهای XRD پیک پروسکایت در 14/8 روی داده و پیک ضعیف 2HP هم در 12/1، در توافق خوبی است و اثری از پیک فاز زرد

هگزاگونال غیر فتواکتیو FAPbI₃ وجود ندارد. بهنظر میرسد همانطوری که پیش بینی شده بود تزری کاتیون ترکیبی Rb-Cs ایجاد فاز زرد را متوقف کرده است و شدت پیک پروسکایت را افزایش داده است. این اثر باعث خلوص و بلورینگی بیشتر پروسکایت شده است.



شکل3. الگوی پراش (XRD) مربوط به پروسکایت حاوی کاتیون RbCs.



شکل4. الگوی پراش(XRD) مربوط به پروسکایت حاوی کاتیون Cs.

بهطور کلی اضافه کردن کاتیونهای ترکیبی از یک سو باعث کاهش شعاع یونی مؤثر و افزایش فاکتور تلرانس گلدشمیت و افزایش آنتروپی سیستم میشود که این موضوع در نهایت باعث افزایش پایداری سلول و از سوی دیگر باعث افزایش طیف جذب نور، متوقف کردن فاز دلتای زرد و افزایش بلورینگی پروسکایت

مى شود. نتيجه اين اثرات، باعث افزايش بازده سلول می شود. علاوه بر این اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبيديم-سزيم به كاتيون FA/MA باعث جداسازى بهتر پیکها و هدایت فاز فتواکتیو پروسکایت بهسمت ساختار مکعبی شده است که این نتیجه با کارهای قبلی در توافق خوبی است [17]. هرچه پیکهای ثانویه پروسکایت یا شدت پیک پروسکایت بیشتر باشد نشان دهندهٔ عملکرد خوب سلول میباشد. هرچه شدت پیک PbI2 بیشتر باشد نشان دهندهٔ وجود ناخالصی بیشتر در یروسکایت می باشد و باعث کاهش انتقال بار و کاهش بازدهی سلول میشود. همچنین افزایش تعداد کاتیونها به پروسکایتهای هالید ترکیبی برم-ید باعث افزایش طیف جذبی نور می شود و این اثر باعث بهبود بازده و پایداری سلول میشود که این نتایج در کارهای محققین دیگر نیز گزارش شده است [17]. انتظار میرود که سلول چهاركاتيونهٔ اين تحقيق كه شامل MA و FA و روبیدیم-سزیم هستند (Rb/Cs)، بازده و یایداری بهتری نسبت به سلول های سه کاتیونهٔ نمونهٔ شاهد که شامل MA و FA و سزیم(Cs) هستند، داشته باشند. استفاده از کاتیون های ترکیبی چهارگانه باعث کاهش غلظت کاتیون،ا نیز میشود که تأثیر قابل توجهی بر تفکیک فازها و پایداری بیشتر پروسکایت دارد. متوقف کردن فاز زرد در ترکیب جدید پروسکایت با استفاده از اضافه کردن کاتیون های ترکیبی، روش مفیدی برای بهبود سلول خورشیدی پروسکایتی است. قبل از این بازدههای بالای پروسکایت در نتیجهٔ تنظیمات خیلی دشوار لایه های انتقال دهندهٔ الکترون و حفره بهدست مى آمد. لكن اضافه كردن كاتيون هاى تركيبي بهمادهٔ

جاذب پروسکایت، بدون اینکه تأثیر منفی روی پارامترهای دیگر سلول داشته باشد فاز فتواکتیو پروسکایت را بهبود میبخشد. این کار روش مهم و مفیدی جهت بهبود عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی میباشد.

برای بررسی بیشتر، مورفولوژی سطح سلولهای ساخته شده نیز مورد مطالعه قرار گرفت، چون مورفولوژی نقش کلیدی در عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایت دارد. مورفولوژی ضعیف میتواند باعث ايجاد حفرهها در لايهٔ پروسکايت شود و اين عمل سبب می شود سطح پوشش لایهٔ جاذب نور کاهش یابد. در نتیجه در سیستم اصطلاحاً نشتی و یا بهعبارت دیگر اتصال کوتاه بهوجود میآید این اثر تماس بین لایههای نوع n و p، مسیرهای کوتاه و مقاومت کم داخل سلول ایجاد می کند. بنابراین مقاومت شانت (RSH) یا موازی سلول و در نهایت ولتاژ مدار باز Voc سلول کاهش یافته و فاکتور پرشوندگی² سلول نیز کاهش می یابد. تصاوير SEM نشان مي دهند پروسكايت حاوى كاتيون روبیدیم-سزیم (شکل5) حفرههای کمتری نسبت به پروسکایت حاوی سزیم (شکل6) دارد. همانطور که ذکر شد حفرههای کمتر روی سطح کریستالی پروسکایت باعث انتقال بار بهتر در داخل سلول می شود. همچنین باعث کاهش بهدام افتادگی حامل های بار میشود. انتقال بار بیشتر و بهدام افتادگی کمتر حامل ها تأثير قابل توجهي بر روى جريان در داخل

سلول خورشیدی دارد و در نهایت باعث افزایش بازده سلول میشود (**39)**.



شکل5. تصویر SEM از پروسکایت حاوی کاتیون RbCs طول مقیاس روی تصویر 8 میکرون می باشد.

² Fill Factor



شکل 6: تصویر SEM از پروسکایت حاوی کاتیون Cs. طول مقیاس روی تصویر 8 میکرون میباشد.

نتيجه گيري

با توجه بهاینکه یکی از راههای بهبود و توسعهٔ سلولهای خورشیدی پروسکایتی، مهندسی مادهٔ جاذب سلول و کار بر روی تغییر کاتیونها و مخصوصاً استفاده از کاتیونهای ترکیبی است، از این رو در این تحقیق، در یک نمونه کاتیون ترکیبی جدید RbCs به پروسکایت هالید و کاتیون ترکیبی اضافه شد و در نمونهٔ دیگر بهعنوان نمونهٔ شاهد کاتیون Cs بههمان پروسکایت هالید و کاتیون ترکیبی اضافه گردید. سپس

SEM و XRD و همچنین اندازه گیری جریان و ولتاژ که عملکرد سلول را مشخص میکنند، با همدیگر مقایسه شدند. این بررسی ها نشان داد که حفرههای سطحی در پروسکایت کاتیون ترکیبی RbCs کمتر از یروسکایت حاوی کاتیون Cs است. در نتیجه انتقال بار در پروسکایت حاوی کاتیون RbCs بهتر از پروسکایت سلول شاهد میباشد. همچنین طیف XRD نشان داد که شدت پیک پروسکایت سلول حاوی کاتیون RbCs بیشتر از شدت ییک پروسکایت سلول حاوى كاتيون Cs است. اين موضوع نشان دهندهٔ بلورینگی بهتر پروسکایت و خلوص بهتر سلول حاوى كاتيون RbCs نسبت به سلول حاوى كاتيون Cs (سلول شاهد) است. بازدهٔ سلول حاوى كاتيون RbCs نيز بيشتر از بازده سلول حاوى كاتيون Cs بهدست آمد. کار بر روی کاتیونها و استفاده از کاتیونهای ترکیبی روشى مناسبي براي بهبود عملكرد سلولهاي خورشيدى پروسكايتى مىباشد بدون اينكه اثر منفى روی پارامتر های دیگر داشته باشد.

تشکر و قدردانی

مؤلفین از حمایتهای دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین از همکاریهای آزمایشگاه سلولهای خورشیدی دانشگاه صنعتی شریف و آزمایشگاه فوتونیک دانشگاه یزد بهدلیل همکاری در انجام این پروژه تشکر مینمایند.

مرجع ها

[1] N. Memariyani, M. Omrani, M. Minbashi, Efficiency improvement of solar cell of heterogeneous silicone with gallium intrinsic layer, Journal of research of particle systems, *14* (2017) 103-112. محمدجعفر نامور و همكاران

[11] M. Saliba, S. Orlandi, T. Matsui, S. Aghazada, M. Cavazzini, J. P. Correa-Baena, P. Gao, R. Scopelliti, E. Mosconi, K. H. Dahmen, F. De Angelis, A. Abate, A. Hagfeldt, G. Pozzi, M. Graetzel, A molecularly engineered hole-transporting material for efficient perovskite solar cells, *Nature Energy*, *15017* (2016) 1.doi.org /10.1038/nenergy.2015.17

[12] X. Li, D. Bi, C. Yi, J. D. Décoppet, J. Luo, S. M. Zakeeruddin, A. Hagfeldt, M. Grätzel, A vacuum flash-assisted solution process for highefficiency large-area perovskite solar cells, *Science*,**353** (2016) 58–62.

[13] H. Choi, J. Jeong, H. B. Kim, S. Kim, B. Walker, G. H. Kim, G. Y. Kim, Cesium-doped methylammonium lead iodide perovskite light absorber for hybrid solar cells, *Nano Energy*, 7 (2014) 80–85.

[14] J.W. Lee, D. H. Kim, H. S. Kim, S. W. Seo, S. M. Cho, N. G. Park, Formamidinium and cesium hybridization for photo- and moisture-stable perovskite solar cell, *AdV Energy Mater*, *5* (2015) 1310.

[15] C. Yi, J. Luo, S. Meloni, A. Boziki, N. Ashari-Astani, C. Grätzel, S. M. Zakeeruddin, U. Röthlisberger, M. Grätzel, Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells, *Energy Environ, Science*, *9* (2016) 656–662.

[16] Z. Li, M. Yang, J. S. Park, S. H. Wei, J. J. Berry ,K. Zhu, Stabilizing perovskite structures by tuning tolerance factor: Formation of formamidinium and cesium lead iodide solid-state alloys, *Chem Mater*, **28** (2016) 284–292.

[17] M. Saliba, T. Matsui, J. Y. Seo, K. Domanski, J. P. Correa-Baena, M. K. Nazeeruddin, S. M. Zakeeruddin, W. Tress, A. Abate, A. Hagfeldt, M. Grätzel, Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: Improved stability, reproducibility and high efficiency, *Energy Environ, Science*, *9* (2016) 1989–1997.

[18]F. Hao, C. C. Stoumpos, D. H. Cao, R. P. H. Chang, M. G. Kanatzidis, Perovskite photonic sources, *Nat Photonics*, 8 (2014) 489-494.

[19] S. D. Stranks, G. E. Eperon, G. Grancini, C. Menelaou, M. J. Alcocer, T. Leijtens, L. M. Herz, A. Petrozza, H. J. Snaith, Electro-optics of perovskite solar cells, *Science*, *342* (2013) 341-344.

[2] I. Firozi, I. Mohammadi, Designing of nanoplasmonic solar cells based on excitation optical mods of inside the cell, Journal of research of particle systems *,15* (2017) 89-102.

[3] S. D. Stranks, G. E. Eperon, G. Grancini, C. Menelaou, M. J. P. Alcocer, T. Leijtens , L. M. Herz, A. Petrozza, H. J. Snaith, Electron-Hole Diffusion Lengths Exceeding1 Micrometer in an Organometal Trihalide Perovskite Absorber, *Science*, *342* (2013) 342-341.

[4] H. Oga, A.Saeki, Y. Ogomi, S. Hayase, S. Seki, Improved understanding of the electronic and energetic landscapes of perovskite solar cells: high local charge carrier mobility, reduced recombination, and extremely shallow traps, *J Am Chem, Soc*, **136** (2014) 13818-13825.

[5] J. Jeon, J.H. Noh, Y.C. Kim, W.S. Yang, S. Ryu, S. Seok, Solvent engineering for highperformance inorganic-organic hybrid perovskite solar cells, *Nature Mater*, *9* (2014) 897-903.

[6] A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. Miyasaka, Organometal halide perovskites as visible-light Sensitizers for photovoltaic cells, *J Am Chem Soc*, **131** (2009) 6050–6051.

[7] J. H. Im, C. R. Lee, J. W. Lee, S. W. Park, N.
G. Park, 6.5% Efficient Perovskite Quantum-Dot-Sensitized Solar Cell, *Nanoscale*, *3* (2011) 4088-4093.

[8] H. S. Kim, C. R. Lee, J. H. Im, T. Moehl, A. Marchioro, S. J. Moon, R. B. Humphry, J. H. Yum, J. E. Moser, M. Grätzel, N. G. Park, Lead iodide perovskite sensitized all-solid-state submicron thin film mesoscopic solar cell with efficiency exceeding 9%, *Sci Rep*, *2* (2012) 591-596.

[9] National Renewable Energy Laboratory, Best Research-Cell Efficiencies chart: www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg

[10] N. J. Jeon, J. H. Noh, W.S. Yang, Y.C. Kim, S. Ryu, J. Seo, S. L. Seok, Compositional engineering of perovskite materials for highperformance solar cells, *Nature*, *517* (2015) 476– 480.

140

[30] V. M. Goldschmidt, Goldshmidt tolerance factor, *Die Nature wissenschaften*, *14* (1926)477-485.

[31] H. L. Wells, S. Schunemann, S. Brittman, K. Chen, Z. *Anorg*, Halide Perovskite 3D Photonic Crystals for Distributed Feedback Lasers, *Chem*, *4* (2017) 2522-2528.

[32]D. B. Mitzi, K. Liang, Synthesis resistivity and thermal properties of the cubic perovskite NH2CH=NH2SnI3 and related systems, *J Solid State Chem*, **134** (1997) 376–381.

[33] G. Kieslich, S. J. Sun, A.K. Cheetham, Solid-state principles applied to organicinorganic perovskites: New tricks for an old dog, *Chem Science*, **5** (2014) 4712–4715.

[34]F. Hao, C. C. Stoumpos, D. H. Cao, R. P. H. Chang, M. G. Kanatzidis, Lead-free solid-state organic-inorganic halide perovskite solar cells, *Nature Photonics*, 8 (2014) 489–494.

[35] M. Saliba, T. Matsui, K. Domanski, J. I. YouanSeo, A. Ummadisingu, M. Gratzel, Incorporation of Rubidium Cation Perovskite Solar Cells Improves Photovoltaic Performance, *Science*, **354** (2016) 206-209.

[36] Z. Li, M. Yang, J. S. Park, S. H. Wei, J. J. Berry, K. Zhu, Stabilizing Perovskite Structures by Tuning Tolerance Factor: Formation of Formamidinium and Cesium Lead Iodide Solid-State Alloys, *Chemistry of Materials*, **28** (2016) 284-292.

[37]C. Yi, J. Luo, S. Meloni, A. Boziki, N. Ashari-Astani, C. Gratzel, S. M. Zakeeruddin, U. Rothlisberger, M. Gratzel, Entropic stabilization of mixed A-cation ABX₃ metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells, *Energy Environ Science*, 9 (2016) 656-662.

[38]J. W. Lee, D. H. Kim, H. S. Kim, S. W. Seo, S. M. Cho, N. G. Park, Formamidinium and Cesium Hybridization for Photo-and Moisture-Stable Perovskite Solar Cell, *Adv Energy Mater*, *5* (2015) 255-265.

[39] S. Agarwal, P. R. Nair, Pinhole efficiency variation in perovskite solar cells, *Applied*

[20] Q. Dong, Y. Fang, Y. Shao, P. Mulligan, J. Qiu, L. Cao, J. Huang, Electron-Hole Diffusion Lengths, *Science*, **347** (2015) 967-970.

[21] N.J. Jeon, J. Noh, W.S. Yang, Y.C. Kim, J. Soe, *Compositional engineering of perovskite materials for high-performance solar cells, Nature*, *517* (2015) 476–480.

[22] J.W. Lee, J. Brabec, Formamidinium and cesium hybridization for photo- and moisture-stable perovskite solar cell, *Adv Energy Mater*, **5** (2015) 1501310.

[23] M. Kulbak, D. Cahen, J. Hodes, How important is the organic part of lead halides, *J Phys Chem Lett*, **6** (2015) 2452-2456.

[24] C.K. Moller, Lead Halide Perovskite Nanocreystal in the Research, *Nature*, *182* (1958)1436-1436.

[25] Y. Bekenstein, B. A. Koscher, S. W. Eaton, P. Yang, A. P. Alivisatos, Ultrathin Colloidal Cesium Lead Halide Perovskite Nanowire, *J Am Chem Soc*, *137* (2015) 16008-16011.

[26] N. J. Jeon, J. H. Noh, W. S. Yang, Y. C. Kim, S. Ryu, J. Seo, S. L. Seok, Compositional engineering of perovskite materials for high-performance solar cells, *Nature*, *517* (2015) 476-480.

[27] N. J. Jeon, J. H. Noh, W. S. Yang, Y. C. Kim, S. Ryu, J. Seo, S. L. Seok, Solvent engineering for high-performance inorganic-organic hybrid perovskite solar cells, *Nature Material*, *13* (2015) 897-903.

[28] H. Choi, J. Jeong, H. B. Kim, S. Kim, B. Walker, G. H. Kim, J. Y. Kim, Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells, *Nano Energy*, **7** (2014) 80-85.

[29] Z. Li, M. Yang, J. S. Park, S. H. Wei, J. J. Berry, K. Zhu, Stabilizing Perovskite Structures by Tuning Tolerance Factor: Formation of Formamidinium and Cesium Lead Iodide Solid-State Alloys, *Chemistry of Materials*, **28** (2016) 284-292.

141

محمدجعفر نامور و همکاران	ضافەكردن كاتيون تركيبى	ررسی اثر ا		142
	physics,	22	(2017)	163104.
	doi.org/10	.1063/1.4	996315.	